

第 22 回格子欠陥フォーラム・励起ナノプロセス研究会合同シンポジウム 「材料科学のための欠陥制御・評価」

主催：日本物理学会領域 10 格子欠陥・ナノ構造分科，応用物理学会励起ナノプロセス研究会
共催：理化学研究所(申請準備中)

日時：2012 年 9 月 21 日(金)13:30~22 日(土)夕方

場所：マホロバ・マインズ三浦(〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田 3231,
Tel:0120-046-889, <http://www.maholova-minds.com/>)

趣旨：格子欠陥を上手に制御する、すなわち、物質の構造・形状・組成およびその内部・表面に存在する欠陥を、原子・電子レベルで、厳密に制御し、またそれらをさまざまな手法により評価することで、新規ナノ材料の創生や半導体デバイスの高品質・高性能化や超微細化などに生かす努力が続けられています。本研究会では、「材料科学のための欠陥制御・評価」に関して、最前線で活躍する異分野の研究者が一堂に会して、意見交換を通じて基礎研究の充実と応用研究の推進につなげる場とします。

参加費：20,000 円(宿泊・食事代を含む。予算状況により学生は減額の可能性あり。)

定員：60 名

参加申込方法：8 月 31 日(金)までに三原まで。

問合せ・申込先：三原基嗣(大阪大学)TEL&FAX 06-6850-6734

e-mail: mihara@vg.phys.sci.osaka-u.ac.jp

予定講演者一覧 (五十音順)

荒木秀樹 (大阪大学) 「陽電子消滅法による欠陥評価」

安東孝止 (鳥取大学) 「III-V、II-V 半導体での再結合促進欠陥反応」

石谷善博 (千葉大学) 「InN のバンド端発光の低減におけるフォノン放出による非輻射性再結合過程」

上田修 (金沢工業大学) 「半導体発光デバイスの再結合促進欠陥反応による劣化」

宇佐美德隆 (東北大) 「太陽電池用シリコン系結晶における歪み・欠陥制御」

大谷昇 (関西学院大) 「電力デバイス用SiC単結晶中の拡張欠陥」

大野裕 (東北大) 「ZnO 中の転位の光学特性と制御」

河野日出夫 (大阪大) 「ナノワイヤのジュール加熱による構造変化のTEM その場観察」

小林義男 (理研) 「インビームメスバウアー分光による新規化学形態探索」

佐藤渉 (金沢大) 「酸化亜鉛中に導入した不純物位置での局所構造観察」

澤野憲太郎 (東京都市大) 「イオン注入によるSiGe ヘテロ構造の欠陥および歪み制御」

篠塚雄三 (和歌山大学) 「半導体中の欠陥反応の機構 -phonon-kick 機構を中心に」

白井光雲 (大阪大学) 「融液からのシリコン成長における引き上げ速度と温度勾配 -理論からのアプローチ」

末岡浩治 (岡山県立大) 「半導体Si, Ge 結晶中の不純物金属の挙動に関する第一原理解析」

太子敏則 (信州大学) 「液状B203 で覆った融液から育成したCZ-Ge 結晶中の欠陥評価」

中村芳明 (大阪大学) 「ナノドットを用いて歪制御したSi 基板上への高品質エピタキシャル薄膜成長法」

山本哲也 (高知工科大) 「酸化亜鉛透明導電膜における格子欠陥誘導の電気・光学・耐湿特性の制御」